

[calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com)[unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)

# Dispositifs à transistors avancés Formules

calculatrices !

Exemples!

conversions !

Signet [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com), [unitsconverters.com](http://unitsconverters.com)Couverture la plus large des calculatrices et croissantes - **30 000+ calculatrices !**Calculer avec une unité différente pour chaque variable - **Dans la conversion d'unité intégrée !**La plus large collection de mesures et d'unités - **250+ Mesures !**

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)© [calculatoratoz.com](http://calculatoratoz.com). A [softusvista inc.](#) venture!

## Liste de 20 Dispositifs à transistors avancés Formules

### Dispositifs à transistors avancés ↗

#### FET ↗

##### 1) Capacité de drain de grille du FET ↗

**fx**  $C_{gd(fet)} = \frac{T_{gd-off(fet)}}{\left(1 - \frac{V_{gd(fet)}}{\Psi_0(fet)}\right)^{\frac{1}{3}}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $6.475557F = \frac{6.47s}{\left(1 - \frac{0.0128V}{4.976V}\right)^{\frac{1}{3}}}$

##### 2) Capacité de source de porte du FET ↗

**fx**  $C_{gs(fet)} = \frac{T_{gs-off(fet)}}{\left(1 - \left(\frac{V_{ds(fet)}}{\Psi_0(fet)}\right)\right)^{\frac{1}{3}}}$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $6.805694F = \frac{2.234s}{\left(1 - \left(\frac{4.8V}{4.976V}\right)\right)^{\frac{1}{3}}}$

##### 3) Courant de drain du FET ↗

**fx**  $I_{d(fet)} = I_{dss(fet)} \cdot \left(1 - \frac{V_{ds(fet)}}{V_{cut-off(fet)}}\right)^2$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.301384mA = 0.69mA \cdot \left(1 - \frac{4.8V}{2.89V}\right)^2$

##### 4) Courant de drainage de la région ohmique du FET ↗

**fx**  $I_{d(fet)} = G_{o(fet)} \cdot \left(V_{ds(fet)} + \frac{3}{2} \cdot \frac{\left(\Psi_0(fet) + V_{ds(fet)} - V_{ds(fet)}\right)^{\frac{3}{2}} - \left(\Psi_0(fet) + V_{ds(fet)}\right)^{\frac{3}{2}}}{\left(\Psi_0(fet) + V_{off(fet)}\right)^{\frac{1}{2}}}\right)$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

**ex**  $0.305501mA = 0.24mS \cdot \left(4.8V + \frac{3}{2} \cdot \frac{(4.976V + 4.8V - 4.8V)^{\frac{3}{2}} - (4.976V + 4.8V)^{\frac{3}{2}}}{(4.976V + 63.56V)^{\frac{1}{2}}}\right)$



## 5) Gain de tension du FET ↗

$$\text{fx } A_{v(\text{fet})} = -G_m(\text{fet}) \cdot R_d(\text{fet})$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } -0.0064V = -0.02\text{mS} \cdot 0.32\text{k}\Omega$$

## 6) Pincer la tension du FET ↗

$$\text{fx } V_{\text{off}(\text{fet})} = V_{\text{ds-off}(\text{fet})} - V_{\text{ds}(\text{fet})}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 63.36V = 68.16V - 4.8V$$

## 7) Tension de source de drain du FET ↗

$$\text{fx } V_{\text{ds}(\text{fet})} = V_{\text{dd}(\text{fet})} - I_{\text{d}(\text{fet})} \cdot (R_d(\text{fet}) + R_s(\text{fet}))$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 4.8407V = 5V - 0.3\text{mA} \cdot (0.32\text{k}\Omega + 0.211\text{k}\Omega)$$

## 8) Transconductance du FET ↗

$$\text{fx } G_m(\text{fet}) = \frac{2 \cdot I_{\text{dss}(\text{fet})}}{V_{\text{off}(\text{fet})}} \cdot \left(1 - \frac{V_{\text{ds}(\text{fet})}}{V_{\text{off}(\text{fet})}}\right)$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 0.020072\text{mS} = \frac{2 \cdot 0.69\text{mA}}{63.56V} \cdot \left(1 - \frac{4.8V}{63.56V}\right)$$

## IGBT ↗

## 9) Capacité d'entrée de l'IGBT ↗

$$\text{fx } C_{\text{in}(\text{igbt})} = C_{(\text{g-e})(\text{igbt})} + C_{(\text{g-c})(\text{igbt})}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 5.76F = 0.21F + 5.55F$$

## 10) Chute de tension dans l'IGBT à l'état ON ↗

$$\text{fx } V_{\text{ON}(\text{igbt})} = i_{\text{f}(\text{igbt})} \cdot R_{\text{ch}(\text{igbt})} + i_{\text{f}(\text{igbt})} \cdot R_{\text{d}(\text{igbt})} + V_{\text{j1}(\text{igbt})}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 20.2533V = 1.69\text{mA} \cdot 10.59\text{k}\Omega + 1.69\text{mA} \cdot 0.98\text{k}\Omega + 0.7V$$

## 11) Courant émetteur de l'IGBT ↗

$$\text{fx } I_{\text{e}(\text{igbt})} = I_{\text{h}(\text{igbt})} + i_{\text{e}(\text{igbt})}$$

[Ouvrir la calculatrice ↗](#)

$$\text{ex } 12.523\text{mA} = 12.2\text{mA} + 0.323\text{mA}$$



## 12) Courant nominal continu du collecteur de l'IGBT ↗

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$f_x i_{f(\text{igbt})} = \frac{-V_{ce(\text{igbt})} + \sqrt{(V_{ce(\text{igbt})})^2 + 4 \cdot R_{ce(\text{igbt})} \cdot \left( \frac{T_{jmax(\text{igbt})} - T_{c(\text{igbt})}}{R_{th(jc)(\text{igbt})}} \right)}}{2 \cdot R_{ce(\text{igbt})}}$$

$$ex 1.691553mA = \frac{-21.56V + \sqrt{(21.56V)^2 + 4 \cdot 12.546k\Omega \cdot \left( \frac{283^\circ C - 250^\circ C}{0.456k\Omega} \right)}}{2 \cdot 12.546k\Omega}$$

## 13) Dissipation de puissance maximale dans l'IGBT ↗

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$f_x P_{max(\text{igbt})} = \frac{T_{jmax(\text{igbt})}}{\theta_{j-c}(\text{igbt})}$$

$$ex 110.2597W = \frac{283^\circ C}{289^\circ}$$

## 14) Temps d'arrêt de l'IGBT ↗

$$f_x T_{off(\text{igbt})} = T_{dl(\text{igbt})} + t_{f1(\text{igbt})} + t_{f2(\text{igbt})}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$ex 3.472s = 1.15s + 1.67s + 0.652s$$

## 15) Tension de claquage de la polarisation directe de l'IGBT ↗

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$f_x BV_{soa(\text{igbt})} = \frac{5.34 \cdot 10^{13}}{(N_p(\text{igbt}))^{\frac{3}{4}}}$$

$$ex 37.53628V = \frac{5.34 \cdot 10^{13}}{(16e15C)^{\frac{3}{4}}}$$

## 16) Tension de saturation de l'IGBT ↗

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$f_x V_{c-e(\text{sat})(\text{igbt})} = V_{B-E(\text{pnp})(\text{igbt})} + I_{d(\text{igbt})} \cdot (R_{s(\text{igbt})} + R_{ch(\text{igbt})})$$

$$ex 1222.25V = 2.15V + 105mA \cdot (1.03k\Omega + 10.59k\Omega)$$



**TRIAC****17) Courant de charge moyen du TRIAC**

$$\text{fx } I_{\text{avg(triac)}} = \frac{2 \cdot \sqrt{2} \cdot I_{\text{rms(triac)}}}{\pi}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$\text{ex } 0.081028\text{mA} = \frac{2 \cdot \sqrt{2} \cdot 0.09\text{mA}}{\pi}$$

**18) Courant de charge RMS du TRIAC**

$$\text{fx } I_{\text{rms(triac)}} = \frac{I_{\text{peak(triac)}}}{2}$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$\text{ex } 0.09\text{mA} = \frac{0.18\text{mA}}{2}$$

**19) Dissipation de puissance du TRIAC**

$$\text{fx } P_{\text{max(triac)}} = V_{\text{knee(triac)}} \cdot I_{\text{avg(triac)}} + R_s(\text{triac}) \cdot I_{\text{rms(triac)}}^2$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$\text{ex } 0.294215\text{mW} = 3.63\text{V} \cdot 0.081028\text{mA} + 0.0103\text{k}\Omega \cdot (0.09\text{mA})^2$$

**20) Température de jonction maximale du TRIAC**

$$\text{fx } T_{j\text{max(triac)}} = T_a(\text{triac}) + P_{(\text{triac})} \cdot R_{\text{th(j-a)}}(\text{triac})$$

[Ouvrir la calculatrice](#)

$$\text{ex } 196.12^\circ\text{C} = 102.4^\circ\text{C} + 0.66\text{W} \cdot 0.142\text{k}\Omega$$



## Variables utilisées

- $A_{v(fet)}$  Gain de tension FET (Volt)
- $BV_{soa(igbt)}$  Tension de claquage SOA IGBT (Volt)
- $C_{(g-c)(igbt)}$  Capacité porte à collecteur (IGBT) (Farad)
- $C_{(g-e)(igbt)}$  Capacité porte-émetteur (IGBT) (Farad)
- $C_{gd(fet)}$  Capacité de drain de porte FET (Farad)
- $C_{gs(fet)}$  FET de capacité de source de porte (Farad)
- $C_{in(igbt)}$  Capacité d'entrée (IGBT) (Farad)
- $G_m(fet)$  FET à transconductance directe (millisiemens)
- $G_o(fet)$  FET de conductance de canal (millisiemens)
- $I_{avg(triac)}$  Courant de charge moyen TRIAC (Milliampère)
- $I_d(fet)$  Courant de vidange FET (Milliampère)
- $I_d(igbt)$  Courant de drain (IGBT) (Milliampère)
- $I_{dss(fet)}$  Courant de drain de polarisation zéro (Milliampère)
- $i_{e(igbt)}$  Courant électronique (IGBT) (Milliampère)
- $i_{e(igbt)}$  Courant d'émetteur (IGBT) (Milliampère)
- $i_f(igbt)$  Courant direct (IGBT) (Milliampère)
- $I_h(igbt)$  Courant de trou (IGBT) (Milliampère)
- $I_{peak(triac)}$  TRIAC de courant de crête (Milliampère)
- $I_{rms(triac)}$  TRIAC actuel RMS (Milliampère)
- $N_p(igbt)$  Charge positive nette (IGBT) (Coulomb)
- $P_{(triac)}$  TRIAC de puissance de dissipation (Watt)
- $P_{max(igbt)}$  Dissipation de puissance maximale (IGBT) (Watt)
- $P_{max(triac)}$  TRIAC de dissipation de puissance maximale (Milliwatt)
- $R_{ce(igbt)}$  Résistance du collecteur et de l'émetteur (IGBT) (Kilohm)
- $R_{ch(igbt)}$  Résistance du canal N (IGBT) (Kilohm)
- $R_d(fet)$  FET de résistance de drainage (Kilohm)
- $R_d(igbt)$  Résistance à la dérive (IGBT) (Kilohm)
- $R_s(fet)$  Source Résistance FET (Kilohm)
- $R_s(igbt)$  Résistance à la conductivité IGBT (Kilohm)
- $R_s(triac)$  Conductivité Résistance TRIAC (Kilohm)
- $R_{th(j-a)(triac)}$  Jonction au TRIAC de résistance thermique ambiante (Kilohm)



- $R_{th(jc)}$  Résistance thermique (IGBT) (Kilohm)
- $T_a$ (triac) Température ambiante TRIAC (Celsius)
- $T_c$ (igbt) Température du boîtier IGBT (Celsius)
- $T_{dl}$ (igbt) Temps de retard (IGBT) (Deuxième)
- $t_{f1}$ (igbt) Temps de chute initial (IGBT) (Deuxième)
- $t_{f2}$ (igbt) Heure de chute finale (IGBT) (Deuxième)
- $T_{gd-off(fet)}$  Capacité de drain de grille Temps d'arrêt FET (Deuxième)
- $T_{gs-off(fet)}$  Capacité de la source de porte Temps d'arrêt FET (Deuxième)
- $T_{jmax(igbt)}$  Jonction de fonctionnement maximale (IGBT) (Celsius)
- $T_{jmax(triac)}$  TRIAC de jonction de fonctionnement maximale (Celsius)
- $T_{off(igbt)}$  Heure d'arrêt (IGBT) (Deuxième)
- $V_{B-E(pnp)}$ (igbt) Tension de l'émetteur de base PNP IGBT (Volt)
- $V_{ce}$ (igbt) Tension totale du collecteur et de l'émetteur (IGBT) (Volt)
- $V_{c-e(sat)}$ (igbt) Tension de saturation collecteur-émetteur (IGBT) (Volt)
- $V_{cut-off(fet)}$  Tension de coupure FET (Volt)
- $V_{dd(fet)}$  Tension d'alimentation au drain FET (Volt)
- $V_{ds(fet)}$  Tension de source de drain FET (Volt)
- $V_{ds-off(fet)}$  Pincez OFF Drain Source Tension FET (Volt)
- $V_{gd(fet)}$  Tension porte à drain FET (Volt)
- $V_{j1}$ (igbt) Tension Pn Jonction 1 (IGBT) (Volt)
- $V_{knee}$ (triac) TRIAC de tension de genou (Volt)
- $V_{off(fet)}$  Tension de pincement (Volt)
- $V_{ON}$ (igbt) Chute de tension sur scène (IGBT) (Volt)
- $\theta_{j-c}$ (igbt) Jonction à l'angle du boîtier (IGBT) (Degré)
- $\Psi_0$ (fet) FET de potentiel de surface (Volt)



## Constantes, Fonctions, Mesures utilisées

- **Constante:** pi, 3.14159265358979323846264338327950288  
Constante d'Archimède
- **Fonction:** sqrt, sqrt(Number)  
*Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné.*
- **La mesure:** Temps in Deuxième (s)  
Temps Conversion d'unité 
- **La mesure:** Courant électrique in Milliampère (mA)  
Courant électrique Conversion d'unité 
- **La mesure:** Température in Celsius (°C)  
Température Conversion d'unité 
- **La mesure:** Charge électrique in Coulomb (C)  
Charge électrique Conversion d'unité 
- **La mesure:** Du pouvoir in Watt (W), Milliwatt (mW)  
Du pouvoir Conversion d'unité 
- **La mesure:** Angle in Degré (°)  
Angle Conversion d'unité 
- **La mesure:** Capacitance in Farad (F)  
Capacitance Conversion d'unité 
- **La mesure:** Résistance électrique in Kilohm (kΩ)  
Résistance électrique Conversion d'unité 
- **La mesure:** Conductivité électrique in millisiemens (mS)  
Conductivité électrique Conversion d'unité 
- **La mesure:** Potentiel électrique in Volt (V)  
Potentiel électrique Conversion d'unité 



## Vérifier d'autres listes de formules

- Dispositifs à transistors avancés Formules ↗
- Dispositifs à transistors de base Formules ↗
- Hachoirs Formules ↗
- Redresseurs contrôlés Formules ↗
- Entrainements CC Formules ↗
- Onduleurs Formules ↗
- Redresseur contrôlé au silicium Formules ↗
- Régulateur de commutation Formules ↗
- Redresseurs non contrôlés Formules ↗

N'hésitez pas à PARTAGER ce document avec vos amis !

## PDF Disponible en

[English](#) [Spanish](#) [French](#) [German](#) [Russian](#) [Italian](#) [Portuguese](#) [Polish](#) [Dutch](#)

5/15/2024 | 5:04:19 AM UTC

[Veuillez laisser vos commentaires ici...](#)

